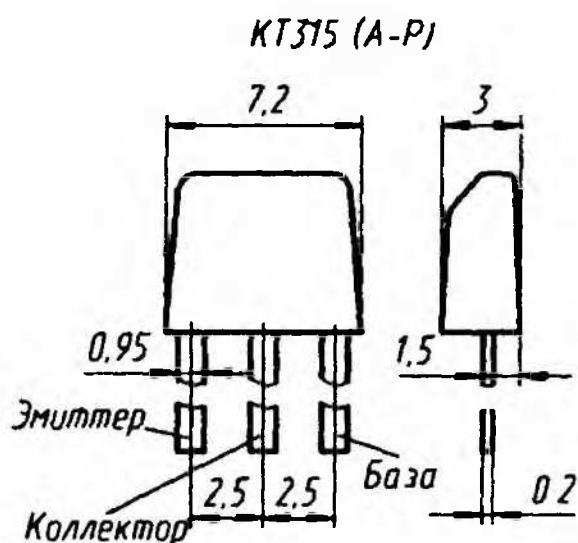


## КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усиленные. Предназначены для применения в усилителях высокой, промежуточной и низкой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке, а также на корпусе прибора в виде буквы соответствующего типоминимала.

Масса транзистора не более 0,18 г.

Изготовители — акционерное общество «Кремний», г. Брянск, Нальчинский завод полупроводниковых приборов, г. Нальчик, завод при НИИПП, г. Томск.

### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кз} = 10$  В,  $I_k = 1$  мА:

КТ315А, КТ315В .....	30...120
КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е .....	50...350
КТ315Д.....	20...90
КТ315Ж.....	30...250
КТ315И, не менее .....	30
КТ315Р .....	150...350

Граничная частота коэффициента передачи тока при  $U_{кз} = 10$  В,  $I_k = 1$  мА, не менее..... 250 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при  $U_{кб} = 10$  В,  $I_3 = 5$  мА, не более:

КТ315А .....	300 пс
КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р .....	500 пс
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж.....	1000 пс
КТ315И.....	950 пс

Граничное напряжение при  $I_3 = 5$  мА, не менее:

КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж .....	15 В
КТ315В, КТ315Д, КТ315И .....	30 В
КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р.....	25 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер	
при $I_K = 20$ мА, $I_E = 2$ мА, не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	0,4 В
КТ315Д, КТ315Е .....	0,6 В
КТ315Ж.....	0,5 В
КТ315И.....	0,9 В
Напряжение насыщения база—эмиттер	
при $I_K = 20$ мА, $I_E = 2$ мА, не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	1 В
КТ315Д, КТ315Е .....	1,1 В
КТ315Ж.....	0,9 В
КТ315И.....	1,3 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В,	
не более.....	1 мкА
Обратный ток коллектор—эмиттер	
при $R_{БЭ} = 10$ кОм, $U_{КЭ} = U_{КЭ, \text{МАКС}}$ , не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,	
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р .....	1 мкА
КТ315Ж.....	10 мкА
КТ315И.....	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В для	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д,	
КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р, не более..	50 мкА
Входное сопротивление при $U_{КЭ} = 10$ В,	
$I_K = 1$ мА, не менее .....	40 Ом
Выходная проводимость при $U_{КЭ} = 10$ В,	
$I_K = 1$ мА, не более .....	0,3 мкСм
Емкость коллекторного перехода	
при $U_{КБ} = 10$ В, не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,	
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р .....	7 пФ
КТ315Ж, КТ315И .....	10 пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер	
при $R_{БЭ} = 10$ кОм:	
КТ315А .....	25 В
КТ315Б, КТ315Ж .....	20 В
КТ315В, КТ315Д .....	40 В
КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р.....	35 В
КТ315И.....	60 В
Постоянное напряжение база—эмиттер.....	6 В
Постоянный ток коллектора:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,	

КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р ..... 100 мА

КТ315Ж, КТ315И ..... 50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при  $T \leq +25^\circ\text{C}$ :

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,  
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р ..... 150 мВт

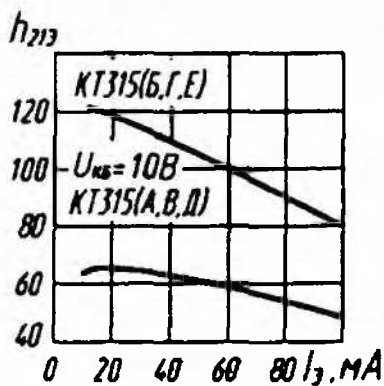
КТ315Ж, КТ315И ..... 100 мВт

Тепловое сопротивление переход—среда .....  $0,67^\circ\text{C}/\text{мВт}$

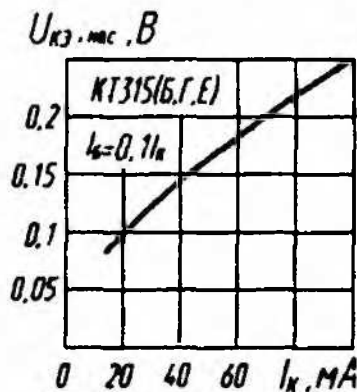
Температура р-п перехода .....  $+120^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды .....  $-60\dots+100^\circ\text{C}$

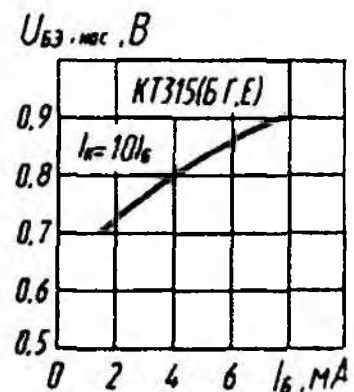
Допускается эксплуатация транзисторов в режиме  $P_K = 250$  мВт при  $U_{КБ} = 12,5$  В,  $I_K = 20$  мА.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока базы